

A842A, A842B

Транзисторы кремниевые полевые эпитаксиально-планарные с изолированным затвором и индуцированным каналом *n*-типа переключательные. Предназначены для применения во вторичных источниках электропитания, переключающих и импульсных устройствах, в ключевых стабилизаторах и преобразователях напряжения, в усилителях, генераторах и другой аппаратуре. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами. На корпус наносится условная маркировка: A842A — одна белая точка, A842B — две белые точки. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 6 г.

Изготовитель — научно-производственная фирма «Омега», г. Москва.

Электрические параметры

Крутизна характеристики при $U_{СИ} = 30$ В,

$I_c = 2,5$ А, $t_i = 600$ мкс, $Q = 200$, не менее 2 А/В

Начальный ток стока при $U_{СИ} = 30$ В, $U_{ЗИ} = 0$,

не более 5 мА

Ток стока при $U_{СИ} = 30$ В, $U_{ЗИ} = 25$ В,

$t_i = 600$ мкс, $Q = 200$, не менее:

 A842A 7 А

 A842Б 8 А

Остаточный ток стока при $U_{ЗИ} = -10$ В,

не более:

 A842A при $U_{СИ} = 500$ В 10 мА

 A842Б при $U_{СИ} = 400$ В 10 мА

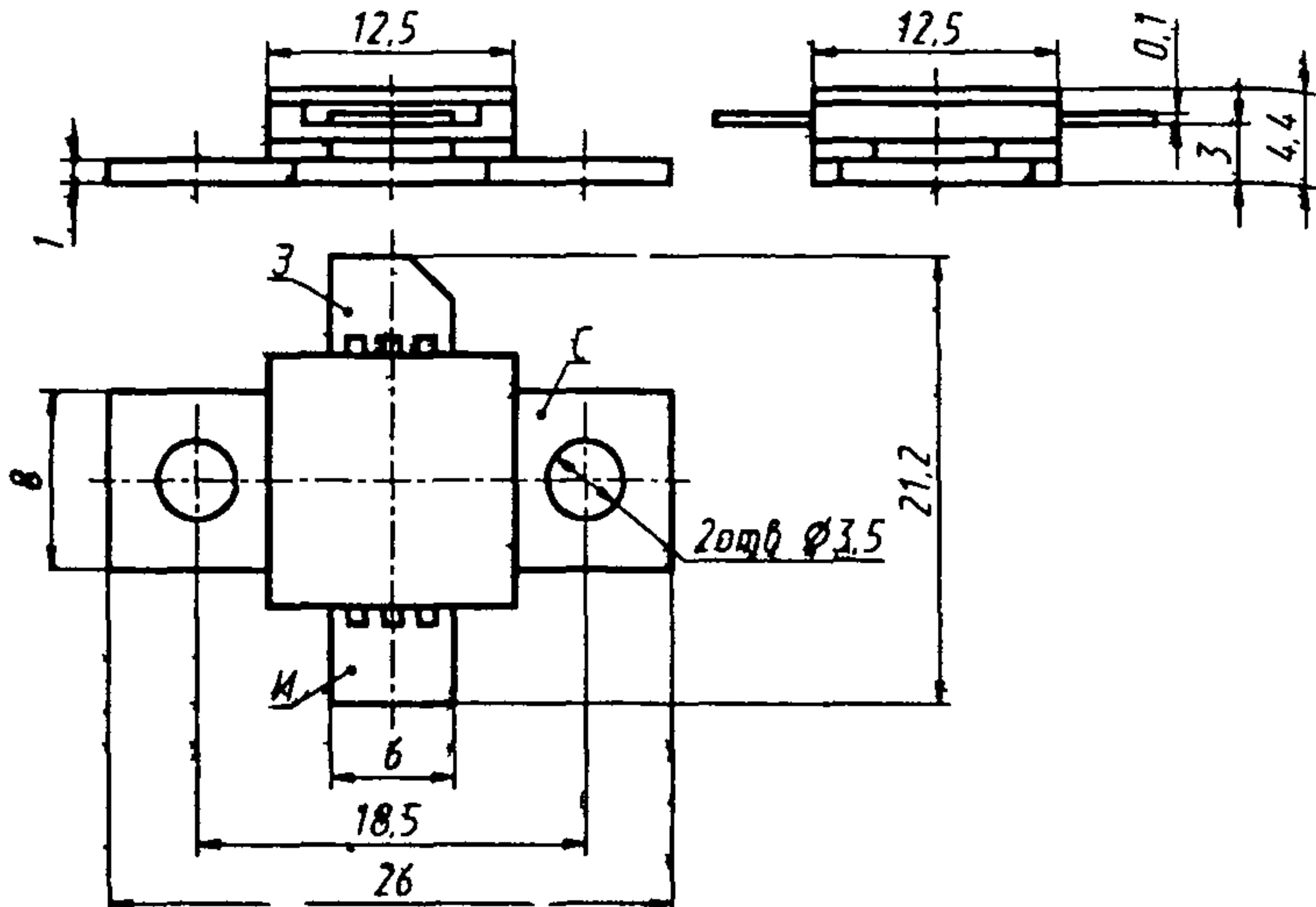
Сопротивление сток—исток в открытом со-

стоянии при $U_{ЗИ} = 20$ В, $I_c = 0,5$ А, не более:

 A842A 2 Ом

 A842Б 1,5 Ом

A-842(А Б)



Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток—исток:

A842A	500 В
A842Б	400 В

Постоянное напряжение затвор—сток:

A842A	510 В
A842Б	410 В

Постоянное напряжение затвор—исток

25 В

Потенциал статического электричества

200 В

Постоянная рассеиваемая мощность¹:

$T_K = -60 \dots +35^\circ\text{C}$	40 Вт
$T_K = +125^\circ\text{C}$	17,5 Вт

Температура окружающей среды

$-60 \dots T_K = +125^\circ\text{C}$

¹ При $T_K = +35 \dots +125^\circ\text{C}$ максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность снижается линейно.

² Допускается параллельное включение транзисторов без выравнивающих элементов при $U_{ЗИ} = 15$ В.

Допускается изгиб выводов на расстоянии от корпуса не менее 3 мм.

Транзисторы пригодны для монтажа в аппаратуре пайкой паяльником. Допустимое число перепаек выводов — 3. Рас-

стояние от корпуса до места лужения и пайки по длине вывода не менее 3 мм, температура припоя +265 °С, время пайки не более 3 с.

Шероховатость контактирующей поверхности теплоотвода должна быть не более 1,6 мкм, неплоскость не более 0,02 мм. Для уменьшения контактного сопротивления между корпусом и теплоотводом следует применять смазки, например, КПТ-8. Допускается вайка фланца корпуса транзистора к теплоотводу, температура пайки не более +160 °С.